

# 将来の光デバイスに向けた成長及びプロセス要素技術の最新動向

日時: 2022年9月6日(火) 13:00-16:55

今後更なる高度化が進む社会インフラを支えるために、光デバイスの重要性はより増していきます。多岐にわたる光デバイスの実現～普及には化合物半導体を中心に成長、エッチング、接合、集積、実装といったプロセス技術の成熟や発展、新たな手法や材料の開発が期待されることから、これら最新の技術動向や展望について議論します。

面内超高密度InAs量子ドットの成長技術とその半導体レーザ応用 山口 浩一, 田中 元幸 (電気通信大学)

AlGaIn系far-UVC発光デバイスおよびGaAs系QCLの結晶成長技術 平山 秀樹, 前田 哲利, 定 昌史, 林 宗澤, 王 利 (理化学研究所)

中性粒子ビームによる無損傷加工と高効率マイクロLEDへの展開 寒川 誠二 (東北大学)

転写プリント法が拓く自在なハイブリッド光集積 太田 泰友 (慶應義塾大学)

AR/VRグラス用超小型レーザーモジュール 小巻 壮 (TDK)

レーザ転写技術を用いた光デバイス実装プロセスの紹介 岡田 達弥, 風間 浩一, 江川 航平, 陣田 敏行, 新井 義之 (東レエンジニアリング)

MEMS技術を用いたTunable VCSELとその応用 S. M. Khan, C. Keum, Y. Xiao, K. Isamoto (Santec), N. Nishiyama (Tokyo Tech), H. Toshiyoshi (The Univ. of Tokyo)